磁気光学効果の基礎と最近の研究の展開

東京農工大学工学系大学院 佐藤勝昭

1. はじめに

磁気光学効果は、固体中の電子の状態、特に、スピン軌道相互作用を介して軌道角運動量 に強くかかわっているため、さまざまな磁性体の物性研究の道具として有用である.この 小文では、磁気光学の基礎を簡単に解説し、それを踏まえ磁気光学効果が磁性体研究にど のように応用されるかについて、人工格子・多層構造磁性体を例に説明する.さらに、磁 気光学の最近の展開について、トピックスを紹介する.

2. 磁気光学の基礎¹

2.1 磁気光学効果の起源の古典電子論的説明

磁気光学効果は、誘電率の非対角成分 ϵ_{xy} から生じる. 荷電粒子に対する古典的な運動方程式を 考えることにより、 ϵ_{xx} 、および、 ϵ_{xy} として、

$$\varepsilon_{xx}(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{(\omega + i/\tau)^2 - \omega_c^2}$$

(1)

 $\varepsilon_{xy}(\omega) = \frac{i\omega_p^2 \omega_c}{\omega (\omega + i/\tau)^2 - \omega_c^2}$

を得る. ここに, $\omega_c = eB/m^*$ はサイクロトロン角周波数, $\omega_p = \sqrt{ne^2/m^*\varepsilon_0}$ は自由電子のプラズマ周波数である.

半導体のマグネトプラズマ共鳴(magneto-plasma resonance)などについては、このような考え方で 実験を説明できることがわかっているが、強磁性体の磁気光学効果は果たしてこのような古典電子 論では5×10⁴テスラもの大きな内部磁界を仮定しなければ説明できない.古典的な電子の運動方程 式によって強磁性体の磁気光学効果を説明することはできないことがわかった.この問題を解決に 導いたのは次に述べる量子論であった.

2.2 磁気光学効果の量子論的起源

動的誘電率は外部電界の印加に対する分極の時間応答を求めるものであるから,時間を含む 摂動計算によって求めることができる.この問題の正確な取扱いは久保の式(Kubo's formula)に基づ いて行われる.詳細は参考書に譲り,エネルギーがとびとびの準位で与えられるような局在電子系に ついて結果だけを示しておくと,誘電率の対角成分,および,非対角成分は,

$$\varepsilon_{xx}(\omega) = 1 - (N_0 e^2 / m \varepsilon_0) \sum_{n < m} \frac{\rho_n (f_x)_{mn}}{(\omega + i / \tau)^2 - \omega_{mn}^2}$$
(2)

$$\varepsilon_{xy}(\omega) = (iN_0 e^2/2m\varepsilon_0) \sum_{n < m} \frac{\rho_n \omega_{mn} \{(f_+)_{mn} - (f_-)_{mn}\}}{\omega \{(\omega + i/\tau)^2 - \omega_{mn}^2\}}$$

のようにローレンツ型(Lorentzian)の分散曲線で表される. ここに $(f_x)_{mn}$, $(f_+)_{mn}$, $(f_-)_{mn}$ は, それぞれ基底状態 $|n\rangle$ と励起状態 $|m\rangle$ との間の直線偏光, 右円偏光および左円偏光に対する電気双極子遷移の振動子強度であって,

$$(f_{x})_{mn} = 2(m\omega_{mn}/\hbar e^{2})|(P_{x})_{mn}|^{2}$$

$$(f_{\pm})_{mn} = (m\omega_{mn}/\hbar e^{2})|(P_{\pm})_{mn}|^{2}$$
(3)

で与えられる.ここに、Pm は電気双極子遷移行列である.また、

 $\rho_n = \exp(-P_n/kT) / \Sigma \exp(-P_n/kT)$ (4)

は, 基底状態|n)の分布を与える.

式(2)は、形の上では古典論から導かれた式(1)とよく似た式になっているが、 ω_c のような explicit な 形では磁界の効果は現れていない.磁化は基底状態内の交換分裂を通じて式(4)の分布関数に影響を与えるとともに、選択則を通じて振動子強度の差(f_+)mn-(f_-)mn に影響を与え、磁気光学効果を もたらす.式(24)の第1式から、誘電率の対角成分の実数部は分散型、虚数部は吸収型のスペクト ルを示すことが分かる.一方、非対角成分について、(24)の第2式を見ると、対角成分とは逆に実数 部が吸収型、虚数部が分散型になっている.

誘電率に非対角成分が現れ、これによって光学活性が生じるためには

(a) $|n\rangle \rightarrow |m\rangle$ の遷移(振動数 ω_{mn}) において,右円偏光に対する振 動子強度 $(f_{+})_{mn}$ と,左円偏光に 対する振動子強度 $(f_{-})_{mn}$ とが異な る. (b) 右円偏光による遷移の分 散の中心の振動数 ω_{+} と左円偏光 による遷移の分散の中心の振動 数 ω_{-} が異なる. (c) 分布関数 ρ_{m} が状態によって異なる. のいずれ かの機構が寄与していればよいこ とが分かる.



図1 電気分極の摂動論による解釈

2.3 誘電率の量子論的解釈

誘電率が式(2)のように,電子 状態間の光学遷移を用いて表さ

れることの物理的な意味を考えてみよう.誘電率 は物質の分極のしやすさを表す量である.さきに 述べたように、分極というのは電磁波の電界によ る摂動を受けて電荷の分布が無摂動のときの分布 からずれる様子を表している.これを図1に示す. いかなる関数も正規直交関数系でフーリエ級数展 開できることはよく知られている.したがって、 電界の摂動を受けて変化した新たな電子波動関数 は、無摂動系の固有関数(基底状態および励起状態 は正規直交完全系であることはいうまでもない)を 使ってフーリエ級数展開できる.ここで、どのよ うな励起状態をどの程度混ぜるかを表しているの が振動子強度fとエネルギー分母 $(\omega - \omega_{j0})^{-1}$ である と解釈できる.

このように考えると実際に遷移の起きる共鳴周 波数より低い周波数の光に対しても、分極が生じ その結果として比誘電率が1 ではない値をとる理



図2電子の軌道各運動量と円偏光の選択則

由が理解できる.すなわち,励起周波数より低い周波数の光の摂動によって,励起状態の波 動関数が部分的に基底状態に取り込まれて,電子の空間分布が変化し分極が起きると解釈さ 講義ノート

れるのである.このプロセスは、仮想的(virtual)であって、エネルギーの消費を伴わない.

非対角成分についての式(24)の第2式をみると、全体にiがかかっているので対角成分と は逆に実数部が吸収型、虚数部が分散型になっている.このことは N^2 の固有値が $N^2 = \epsilon_{xx} \pm i\epsilon_{xy}$ となり、非対角成分にiがかかっていることに対応している.

量子力学の教えるところによれば、右回り、あるいは、左回りの円偏光による電気双極子 遷移が起きるためには、軌道角運動量量子数 L の量子化軸成分(今の場合、光の進行方向の成 分)Lz が基底状態と励起状態とで1 だけ異なっていなければならない、一方、固体中に置かれ た遷移元素の d 電子の基底状態は軌道の角運動量をもたないことが知られているので、基底 状態の軌道角運動量 L は 0 と見なすことができる. L=0 というのは、あたかも、s 電子のよ うに球対称であると考えておいてよい、これに対して、励起状態の L はさまざまの値をとり 得る.いま、磁化の向きが z 方向にあるとすると、基底状態の L_zは 0 なので円偏光で許容遷 移が起きるためには、図2の電子準位図に示すように励起状態の L_zは±1 でなければならない.

 $L_z=\pm 1$ という状態は p 電子的な角度分布をもつ状態と考えればよい.いま, $L_z=\pm 1$ なる

固有値に対応する p 電子状態は, $p_+=p_x+ip_y$ であり, $L_z=-1$ を固有値にもつのは $p_{-=p_x-ip_y}$ であるが,これらの状態はそれ ぞれ電子が z 軸を中心に右回り,および左回りに回転している状態と考えられる.したがって,円偏光によって電子の回転運動を励起しているのであると理解してよい.式(2)は,円偏光によって,角運動量をもった回転する電子状態が基底状態に部分的に 混じってくることによって,誘電率の非対角項が現れることを示している.

これまでの議論では、磁性体の磁化の 効果は explicit には現れていない. 図 3(a) に示すように、磁界(または磁化)のないと き、 L_z =+1 と L_z =-1 の状態は縮退して いる. 磁界が存在すると、図 3(b)に示すよ うにゼーマン効果(または交換分裂)によっ て↑スピンの状態のエネルギーと↓スピンの



図3磁気光学効果におけるスピン軌道相互作用の 重要性を示す図

状態のエネルギーとの間に分裂が起きるが、それだけでは、軌道状態の縮退は解けない.p 電子を例にとると、スピンの異なる p_t 状態と p_t 状態とのエネルギー分裂は起きるが、磁気光 学効果に必要な右回りの回転運動をする軌道(p_+)と左回りの回転運動をする軌道(p_-)とのエ ネルギー分裂は起きない.ここでスピン軌道相互作用が存在すると、図 3(c)のようにスピン の向きと軌道角運動量とが結びつき、全角運動量 J(=L+S)が状態を表すよい量子数となる. p 電子についていえば、J=3/2 に対応するのが p_{+1} 軌道、および、 p_{-1} 軌道であり、J=1/2 に 対応するのが p_{-1} 軌道および p_{+1} 軌道である.

もし基底状態の分裂が熱エネルギーkTに比べ十分に大きければ、基底状態は↑スピン電子だけとなるので、右円偏光による $J_z = +1/2 \rightarrow J_z = +3/2$ の遷移と左円偏光による $J_z = +1/2 \rightarrow J_z = -1/2$ の遷移のみが現れ、その遷移エネルギーの違いから磁気光学効果が起きる.↓スピンからの遷移は↑スピンからの遷移とは逆のスペクトル応答が期待される.このため基底状態の↑スピン状態の数 n_1 と、↓スピン状態の数 n_1 の分布を考慮せねばならない.もし、基底状態において n_1 と n_1 が同数であれば、遷移が起きても軌道状態の変化は打ち消してしまう.

上のような理由で,磁気光学効果を表す ε_{xy} の表式には,スピン偏極率 $<\sigma>=(n_1-n_1)/(n_1+n_1)$ がかかってくる.常磁性体では、 $<\sigma>$ はブリユアン関数 $B_1(B/T)$ で表される.B/Tの十分に小さいとき、この関数はB/Tに比例するが、極低温または強磁界の極限では一定の値に収束する.

一方, 強磁性体では交換相互作用によって, 一方のスピン状態の数が多数となっているので, 磁化がある限り基底状態の↑スピンと↓スピンの数に差があり↑スピンからの遷移が優勢となる. 遷移エネルギーの分裂の大きさは, ゼーマン効果によるものではなく, 励起状態の J₂=+3/2 と-1/2 のエネルギー差を与えるスピン軌道相互作用によるものなので, 磁化または外部磁界に依存しない.

3. 磁気光学スペクトルの物性研究への応用ー人工格子・多層構造磁性体の研究2-

磁気光学スペクトルを物性研究に適用した一例として人工格子・多層構造膜の研究を紹介 しておこう.多層膜や人工格子の構造の寸法が、いろいろの特性長L*にどの程度近いかによ って、さまざまな異なった物性を示す. *L**としては、媒体中の光の波長 *λ*/*n*、界面の乱れ*d*s、 電子のドブロイ波長 *λ*_D、原子のサイズ*a* などが考えられる.

3.1. Fe/Cu, Fe/Au 多層膜の磁気光学効果

繰り返し周期が5 nm から50 nm 程度の人工多層膜を「組成変調人工多層膜」と称してい る. はじめに問題提起をしたのは、片山らであった³. Fe(x Å)とCu(x Å)からなる組成変調多層 構造膜を作製し磁気光学効果を測定したところ、図4(a)に示すようなカー回転スペクトルを得 た. すなわち、Fe/Cu 多層膜の磁気カースペクトルには、磁気光学効果の起源であるFe のス ペクトルには見られないような明瞭なピークが見られ、そのピーク値はFe のカー回転よりも 増大していた. ピーク位置は図4(b)の反射スペクトルに見られる反射率の立ち上がりの波長 (Cu の吸収端)に対応している. この効果は、当初、ミクロスコピックな効果、すなわち、 Cu の3d バンドがFe によるスピン偏極を受けて生じた効果ではないかと考えられたが、その 後筆者らにより誘電率の対角成分が変化することによる実効的な磁気光学効果の増強として、 マクロな取り扱い(仮想光学定数法)によって説明された⁴. 一般の角度から入射した光に対す る解は行列法によって扱うことができる⁵. 繰り返し周期が、媒体中における光の波長であ る *2*/n という特性長に近いことが、光学的な取り扱いを可能にしている. しかし、このよう な純粋に光学的な手法によって問題を解くことができるのは、層間の界面での混じり(合金化) や、非磁性体の磁気偏極などが無視できる場合に限られることを注意しておこう.



図 4 Fe/Cu 組成変調多層構造膜の磁気光学スペクトル と反射スペクトル

図 5 仮想光学定数法で計算した磁気光学および 反射スペクトル

図5 には、仮想光学定数法によって計算した(a)カー回転、および、(b)反射率のスペクトル を示す. それぞれ、図4 に示した実験データをよく再現している. この計算においては、Fe に ついて報告された誘電率 の非対角成分および,Fe, Cuの光学定数を用いただ けで,一切フィッティン グ・パラメータを用いてい ない.光学的シミュレーシ ョンの結果は,実験データ をよく再現しており,層間 の混じりの効果,界面での 磁気 量子閉じこめの効果 がほとんど起きていない ことを示している.



図6Fe/Cuの層厚比を0.62 に固定した多層膜における磁気カー回 転角の変調周期依存性(点は実験値、線は計算値)

図6 には、Fe/Cu の層厚比を0.62 に固定した多層膜における磁気カー回転角の変調周期 依存性を示してある. ▲と△は、それぞれ、Fe 面側およびCu 面側から測定した磁気カー回 転角のピーク値の実験値を表している. 一方、実線と点線は、それぞれ、Fe 面とCu 面の回 転角のシミュレーション結果を示す. これをみると、実験値と計算値は6-40 nm の範囲でよ く一致していることが分かる. 変調周期が5 nm より小さくなると、実験値と計算値のずれが 大きくなる. すなわち、5 nm付近に新たな特性長があることがわかる. この厚みの領域にな ると、通常の作製法では、界面の凹凸や界面付近の相互拡散が無視できない. 従ってこの厚 み以下の多層膜の作製には特別の注意を払わなければならないことがわかる.

3.2. 磁性超薄膜の磁気光学効果⁶

1990 年代に至って,原子層オーダーで制御されたエビタキシャル薄膜作製技術が飛躍的 に進歩した.この結果,層厚を電子のドブロイ波長という特性長程度に制御することが可能 になってきた.鈴木らはMBE 法でMgO 基板上にエピタキシャル成長したAu(100)薄膜の上に Fe 超薄膜を作製し,その上に保護層としてAu の薄いキャップ層をかぶせた三層膜における 新しい光学遷移を見いだした⁷.その後,Au(100)面にエビタキシャル成長したくさび状のFe 超 薄膜にAuの薄いキャップ層をかぶせた膜における磁気光学スペクトルが測定された.このよ うな系の磁気光学効果は,下地層(Au)の誘電率テンソルの対角成分をε^S_{xx}, Fe 層の誘電率テン ソルの非対角成分をε_{rv} として, *d* が十分小さいとき

$$\theta_K + i\eta_K = \frac{2d\omega}{c} \frac{i\varepsilon_{xy}}{1 - \varepsilon_{xx}^S}$$
(5)

で表される. 下地のAu のプラズマ共鳴の周波数でこの式の分母が小さくなるため, 磁気光学 スペクトルに構造が現れる. さらに3.5~4.5eV にかけて, バルクのFe には観測されないよう なピークが現れ, 層厚が大きくなるに従って高エネルギー側にシフトする. 4eV 付近におけ るFe 1層あたりのカー楕円率は, Fe の層厚の増加とともに大きく振動する. 新たに見られた 構造は, Au との接合を作ったことによって, Fe の空いた多数スピンバンドの電子が, Au の バンドギャップ内には入り込めなくなって, Fe 層内に定在波を作って閉じこめを受けること によって生じた量子井戸準位によるものと解釈されている.

一方, Au やCu などの非磁性金属層を2 つの強磁性層で挟んだ交換結合膜において, 層間の 交換結合の層厚依存性がGMR の振動として観測されるが, これに似た振動現象が磁気光学 効果にも観測されている. 層間交換相互作用の非磁性層厚依存振動現象は, 非磁性層の電子 の磁性層界面での反射と干渉を考慮して解析される.

3.3. Fe/Au 人工規則合金

層厚が原子サイズの特性長に近づいたときどのような現象が起きるであろうか. Fe とAu は非固溶の状態図をもち合金を作らない. しかし, MBE 法で作製したFe(1ML)とAu(1ML)からなる人工格子は, Fe とAu の単純な積層ではなく, 天然には存在しないL1₀型の規則合金 構造になることが見いだされている⁸. また, Fe, Au それぞれ数原子層ずつ積層した Fe(xML)/Au(xML)人工格子においても界面には, x=1の人工格子が形成されると考えられる.

筆者らはFe(xML)/Au(xML)人工格子において図7 に示されるような磁気光学スペクトルを 観測した⁹. x が10 より大きいところでは、Au のプラズマ端による増強効果が2.5eV 付近に はっきりと観測されるが、その他には顕著な構造を示さない. ところが、x が8、6 では、4eV 付近に明瞭な構造が現れ、x の減少とともに低エネルギー側にシフトしていく様子がはっき りと観測される. バンド計算に基づいて求めた磁気光学スペクトルは、4eV 付近に磁気光学 構造を予言し、実験結果をほぼ説明することができた¹⁰. どの電子状態がどの光学遷移に対し て寄与するかを見ることにより、4eV 付近のスペクトル構造は、Au の↓スピンの5d バンド

から, Fe の3d 軌道とAu の励 起状態の5f 軌 道が混成した↓ スピンのバンド へので寄与してい ることが明らか になった.



図 7 Fe(xML)/Au(xML)人工格子における磁気光学スペクトルのx依存性

3.4. Pt, Pd と

遷移金属の人工格子

4d 遷移金属Pd, 5d 遷移金属Pt は貴金属の中でも白金族と呼ばれ,強磁性になる直前の非 強磁性体であるとして知られている.白金族と鉄族の合金には,規則相と不規則相が存在す る.L10型の規則合金は正方晶で大きな保磁力をもつことが知られ,永久磁石材料の一種と して研究された.保磁力は,Pt₇₈Fe₂₂では1.57 kOe,Pt₇₇Co₂₃では2.60 kOe と報告されて いる¹¹.白金族と鉄族の合金は短波長で大きな磁気光学効果を示すため,光磁気媒体として期 待された.しかし,合金薄膜は面内磁気異方性を示すため,光磁気媒体としては用いられな い.Carcia らは,Pt/Co,Pd/Co の人工格子薄膜を作製し,これが膜面に垂直な磁気異方性 をもち,短波長光磁気記録媒体として用いられることを明らかにした¹².

(a) Pt/Co 人工格子

中村ら¹³および橋本ら¹⁴は, Pt/Co 多層膜が対応する合金の単一膜とよく似た磁気光学スペクトルを



ルの研究はZeperら15および筆者ら16によってなされた.

図8(a) は層厚がPt(10 Å)/Co(5 Å), Pt(18)/Co(5), Pt(40)/Co(20)の磁気光学スペクト ルをPt₆₀Co₄₀ 合金と比較して示してある.この形状は, Pt(10)/Co(5)人工格子について, Co の ε_{xx} , ε_{xy} とPt の ε_{xx} とを用い, 急峻な界面を仮定した場合には,形状,大きさともに実験結果 を再現できない.界面にPt60Co40 合金層が存在すると仮定し,合金層の厚みをパラメータ としてPt(10)/Co(5)人工格子のスペクトルを仮想光学定数法で計算した.フィッティングから, 合金化していないPt 層0.82Å, Co 層0.38Å,合金層6Å程度という数値が導き出された.同 様にして, Pt(18)/Co(5)では, Pt5.5Å, Co0.26Å,合金層7.8Åという値が得られた.図8 (b) は,各試料につき最もよくフィットした場合のシミュレーション結果を示してある¹⁷.X線 回折のフィッティングから見た場合, 6-8Åという合金層の厚みは大きすぎると思える.

ここでは、合金層があるとして説明したが、Pt の磁気偏極効果を考える必要がある. Schütz らは、円偏光放射光を用い、Pt-Co 系合金のPt の吸収端に明瞭なX 線吸収端のMCD(磁気円 二色性)があることを見いだし¹⁸、Ptがスピン偏極を受けておりその符号はCo と逆方向である ことを明らかにした. また、Fe にわずかに固溶した5d 遷移金属もスピン偏極をもつことが 明らかにされ¹⁹、近接効果による5d 遷移金属のスピン偏極の問題が急速にクローズアップさ れた. Ebert、Akai らは相対論バンド計算によってPt-Fe 合金のPt がスピン偏極を受けること を明らかにし²⁰、伝導率テンソルの対角および非対角要素のスペクトルを計算した. またPt/Fe 人工格子における偏極は合金の60%程度であることを

導きPt のX線MCD を説明した.

(b) Pd/Co 人工格子

Pd/Co 人工格子について中村らは、Pd/Co 多層膜の磁気光学スペクトルをPd とCo が混じり あわない単純な多層膜であるとして解析したが、実験をよく説明できなかった²¹. 筆者のグル ープでは、Pd/Co の人工格子とPdCo 合金について、磁気光学効果を測定し²²、Pt/Co の場合と 同様の仮想光学定数法による解析を行ったが、合金の厚さとしてどのようなものを仮定して も、実験で得たスペクトル(実線)に見られるような3eV 付近の様子を再現できなかった. 異 なった組成のPd-Co 系合金のスペクトルの差スペクトルから「磁気偏極したPd」の磁気光学 スペクトルを推定し、Pd/Co 界面に "magnetic Pd" が存在するとしてシミュレーションを行 った結果、実験で得られたスペクトル構造が比較的よく再現されていることがわかった.

"magnetic Pd"の磁気光学効果を強磁界下の磁気光学スペクトルを用いて測定することは今後の課題である.

4. 磁気光学研究の最近の展開

測定技術の進歩によって,近接場における磁気光学効果,非線形磁気光学効果,内殻磁気 光学効果などが実際に観測されるようになって,微小領域磁性の情報が得られるようになっ てきた.ここでは,これらの新しい展開を概説する.

4.1 近接場磁気光学顕微鏡

磁気光学効果を用いると、磁区の観察ができるが、通常のレンズ光学系を用いて識別できる最小距離dは、回折限界で決まる値d=0.6 λ/NAより小さくすることができない。回折限界以下の微小な磁区の磁気光学イメージを得る方法として、近接場光学顕微鏡(near field optical microscope)を紹介する.

近接場とは何であろうか.全反射光学系において境界面を境にして入射光側と反対側には面に 垂直方向に指数関数的に減衰する電磁界が存在する.このような光の場を近接場またはエバネセント場とよぶ.近接場が観測されるのは、全反射系に限ったことではない. 伝搬する光の場の中に波 長より小さな微小物体(直径dの球とする)を置くと、この物体中には電気双極子が誘起されるが、この 双極子が作る振動電界のうち、小球の直径程度のごく近傍にある電磁界は伝搬せず、距離とともに 単調に減衰する.この光の場も近接場である.近接場の中に微小な散乱体を置くと、ふたたび伝搬 光となるので微小な散乱体を観測することが可能になる.このような近接場を用いて, 微小な物体を 観測しようというアイディアはかなり以前から提案されていたが, 技術的困難さのため長い間実現しな かった.実用的なSNOMの原型となったのは, 1984年のPohlらの論文

であった²³. SNOMによる最初のイメージングは1985年になされ, 20nmという高分解能が得られた²⁴. その後, 細く引き伸ばされたマイク ロピペットを用いたSNOMが開発され²⁵, ピペットのテーパを改良し液 体を満たすことによって空間分解能が向上し, 実用レベルのSNOMが 実現した²⁶. 最近では, マイクロピペットの代わりに細く絞った光ファイ バを用いるのが主流である.

細く絞ったファイバ光学系の先端に設けられた波長より小さな開 ロを第1の散乱体と考え、ここから漏れ出している近接場中に置かれ た微小な構造を第2の散乱体と見てこの散乱光を検出する.このファ イバプローブの開口部を物質の表面上で走査することにより、光の回

折限界以下の画像化をおこなうのが, 走査 型近接場光学顕微鏡SNOM(scanning near-field optical microscope)である. この場 合は, ファイバプローブが光源側なので照 射モードのSNOMと呼ばれる. 逆に, 第1の 散乱体として物質の微細構造を考え, 第2の 散乱体としてファイバプローブ先端の開口を 考える場合を検出モードのSNOMという.

SNOMを利用して微小な磁気構造を観 察する研究は1992年のBetzigらによる報告 ²⁷以来,盛んに行われるようになり,その後, プローブの改良²⁸,制御方法²⁹,³⁰,解析法³¹,



(a) トポグラフ像



図 9 ベントタイプのファイバ・ プローブ先端部の SEM 像



(b) 磁気光学像

図 10 MO-SNOM で観測した Pt/Co 光磁気ディスクに記録 された矢羽根型記録マーク

アーティファクト³²などに関する研究が多く報告されるようになった. しかしながら、ファイバプローブを用いて高いコントラストをもつ磁気光学偏光像を得ることは非常に 難しい.一般にファイバを通る偏光は光弾性のため曲げによる応力や機械的な振動による複屈折を 生じ偏光度が低下する.これが低コントラストの原因である.筆者らは、図9に示すように光ファイバの 先端部を補足引き延ばし彎曲させたベントタイプのプローブをカンチレバーの針として用いるAFM モードのSNOMをベースとして、光弾性変調器(PEM)を用いた偏光変調法³³により検出感度の向上 を図った近接場磁気光学顕微鏡を開発した³⁴.さらに、ストークスパラメータを用いて光ファイバプロ ーブの偏光性をチェックした結果、偏光度が1に近い良質のプローブは、たとえ複屈折による光学的 遅延があったとしても、光学的に補償可能であり、きれいな偏光画像を得ることができることを見出し た³⁵.

図10は、Pt/Co多層膜を用いた光磁気ディスクに記録された矢羽根型記録マーク(幅1µm, 長さ 6µm)のAFMトポグラフ像(左)およびMO-SNOM像(右)である. AFMトポグラフ像には、右下部に案 内溝(グルーブ)のイメージが見えるのみであるが、MO-SNOM像には、案内溝のない部分に記録磁 区形状が明瞭に見られている. この実験に使用したプローブ先端の開口径は80 nmである. プロー ブ先端と試料表面の距離は20-30 nmであった. 溝のある部分では、磁区像に黒い線状の像が重畳 しているが、これは案内溝のゴーストで、プローブが凹凸をなぞっていく際の過渡現象が信号に現れ ているものと解釈されている. 近接プローブ装置特有のアーティファクトといわれる. また、長さ0.2µm の記録マークのMO-SNOM像を分解能約130 nmで明瞭に観測することに成功した³⁶.

4.2 非線形磁気光学効果-磁気誘起第2高調波発生(MSHG)を中心に-37

これまで述べた磁気光学効果はすべて線形の効果,つまり,入射光と同じ波長の出射光についての磁気光学的応答を扱ってきた.これに対して磁性体に誘起された非線形分極によっ

て発生した第2高調波(SH)の出射光についての磁気光学応答が非線形磁気光学効果である. 電気双極子近似の範囲では,2次の非線形分極の*i*成分*P*⁽²⁾は,

 $P_{i}^{(2)}(2\omega) = \chi_{ijk}^{(2)}(2\omega;\omega,\omega) E_{i}^{(1)}(\omega) \cdot E_{k}^{(1)}(\omega)$ (28)

のように表される. $E^{(1)}$, $E^{(1)}$ は1次光の電界の*j*, k成分, $\chi^{(2)}_{jk}(2\omega;\omega,\omega)$ は2次の非線形感受率テンソルである.また、この式において繰り返される添え字については和をとるというテンソル演算の約束に従う.よく知られているようにFe, Coなど中心対称性をもつ物質においては、3階のテンソルは0となるため、第2高調波発生(SHG)が起きない.しかし、表面・界面においては、中心対称が破れているのでSHGを観測することができる³⁸.

また、物質が磁化をもつと対称性が変化し選択則が変化するので、磁化に依存する磁気誘 起SHG(MSHG)が見られる. P(S)偏光の1次光を入射したとき、出射SH光の偏光方向は、入 射光の偏光方向P(S)から傾いた方向を向いており、磁化の向きを変えると、偏光方向はP(S) 面について対称に向きを変える.この効果のことを非線形磁気カー効果(NOMOKE)という.

従って,この効果は磁性/非 磁性人工格子の表面・界面の 磁性の評価にも用いること ができる.この効果は、線形 磁気光学効果にはない新し い観測手段としての多くの 情報を提供するので,磁性人 工格子の研究に欠くことの できない技術になりつつあ る³⁹. 例えば、Feの線形の縦 磁気カー回転はせいぜい 0.1°程度であるのに対し、非 線形カー回転は入射角を小 さくしたとき,80°にも達す ることが報告されている40. また、反強磁性のCr₂O₃にお いてSH光のスペクトルが左 右円偏光に対して異なる選択則 をもち, 隣接する反強磁性磁区に おいては、この選択則が逆転する という報告がなされており41,理 論解析が行われた.

図11は筆者が用いている非線 形磁気光学効果の測定装置であ る.光源としてはモードロック・ チタンサファイア・レーザの810 nmの光を用いている.このレー ザからは100-150 fsのパルス光 が80MHz程度の繰り返しで出力 されており,偏光子P,レンズ, フィルタF1を通して試料面上に 照射される.フィルタF1は光学素 子で発生するSH光をカットする





図 12 Fe(3.5ML)/Au(3.5ML)人工格子について観測された MSHG の試料方位角依存性

ためのものである.光は40µm径のスポットに集光され,パワー密度は1パルスあたり1 GW/cm²にも達している.この強い光の場を受けて,試料表面には2次の非線形分極が誘起さ れる.試料から出射した光は検光子Aを通ったあとフィルタF2によりSH出力(405 nm)のみが 選択され,光電子増倍管(PM)に導かれる.検出された信号は、フォトンカウンティング装置 に導かれる.入射角は45°で,磁界は縦磁気光学配置となっている.

図12に、MgO(100)基板上にエピタキシャル成長したFe/Au人工格子([Fe(3.75原子 層)/Au(3.75原子層)]×30周期)にP偏光(810nm)を入射したときの出射P偏光成分の試料方位角 依存性を示している. (a)は線形(810nm)の方位角依存性, (b)はSH光(405nm)の方位角依存 性のパターンである. 線形では、当然のことながら、等方性のパターンしか見られないのに 対し、非線形のパターンには明らかな4回対称が見られ、しかも、磁化の反転によって、パタ ーンが回転する様子が見られる⁴². MSHGでは、表面・界面における非磁性の結晶構造に起 因する項と表面・界面における磁化依存の項との干渉により方位角依存性のパターンが現れ ている. 一方、検光子を回転しながら、2つの磁化方向についてSH光強度を測定し、角度依 存性のフーリエ解析から2つの曲線のシフトを求めることにより、非線形カー回転角として 23.2°という大きな値を得た. テンソル解析を行うことによって、非線形磁気光学効果は表 面・界面の結晶起源のSHG項と、表面・界面からのMSHG項、および、光の電界の傾斜に基 づく電気四重極子項の干渉により生じていることが導かれる. MSHGのうち方位に依存しな い成分が非線形カー回転に寄与し、方位角依存性を持つ成分が、方位角依存パターンに寄与 することが導かれる.

4.3 X線吸収端の MCD と X線顕微鏡

シンクロトロン放射光(SR)を用いた分光研究の特徴は、内殻に関係した光学遷移を観測で きることである. 強磁性体を構成する原子の X 線吸収端付近の吸収スペクトルを SR で測定 すると磁気円二色性(以下, XMCD と略称)が見られる. XMCD スペクトルは特定の原子の位

置における局所的な磁気モーメント のプローブとして用いることができ る.放射光による磁性研究について は圓山⁴³によるすぐれた解説がある ので詳細はそちらを参照されたい.

ここでは簡単に XMCD の物理的 起源を紹介する⁴⁴. 円偏光光子のエネ ルギーが特定の原子の L 内殻準位の 束縛エネルギー以上になると, 2p_{1/2}(L₂), 2p_{3/2}(L₃)の電子は d 対称性 の終状態にのみ遷移する. 電気双極 子遷移の選択則により右円偏光では 磁気量子数が 1 増加する遷移のみが 許容され, 左円偏光では 1 減少する 遷移のみが許容される.

図13は3d遷移金属のL_{2,3}吸収に 関与するエネルギー準位図と遷移の 様子を示している.簡単のため,3d の多数スピン電子のエネルギー帯は 完全に占有されており少数スピン電 子のエネルギー帯は部分的に占有さ れているとする.(Niではこの仮定が 成立している).このときL殻から多



図 13 d 遷移金属の L_{2,3} 吸収に関与するエネルギー準位図と遷 移の様子 (a) どの m_d 状態も同じ占有状態となる場合(軌道角 運動量の消失状態)(b) m_d 毎に占有の様子が異なる場合

数スピン 3d 帯への遷移は起きず, 少数スピン 3d 帯への遷移のみを 考えればよいので,図には,少数 スピンについてのみ図示してある. 実線は右円偏光による遷移($\Delta l =$ +1),破線は左円偏光による遷移 ($\Delta l = -1$)を表し,カッコの中の数 値は相対的な遷移確率である.図 の一番上には終状態である 3d 電 子帯の占有の様子を描いてある.

もし,図 13(a)のように,どの ma状態も同じ占有状態となるなら ば軌道角運動量が消失しており, スペクトルの形状は図 14(a)のよ



図 14 L_{2,3}吸収スペクトルの形状 (a) どの *m*_d状態も同じ占有状態と なる場合(L₃ と L₂の XMCD は対称的な形状) (b) *m*_d 毎に占有の 様子が異なる場合(L₃ と L₂の XMCD は非対称)

うに L_3 と L_2 の XMCD は対称的な形状となる. これに対して図 13(b)のように m_d ごとに占有 の様子が異なるならば、図 14(b)のように非対称な形となる.

XMCD を測定することによって局所的な磁化が見積もられる. 右左円偏光に対する吸収 係数の差(MCD) Δμ は $|M(E)|^2 \cdot \langle o_z \rangle \cdot \Delta \rho$ のように非占有バンドのスピン密度分布 $\Delta \rho = \rho^+(E) - \rho^-(E)$ に比例するが,これは,ホールのモーメントと定義される. これは実際の 局在モーメントと大きさが同じで,符号が逆である. 従って, XMCD から局所的な磁化を推 測することができる.

Chen らは Ni の L₂, L₃ 吸収端の XMCD の測定を行い, L₂ と L₃ とのスペクトル形状の非対称性を発見した⁴⁵. このスペクトル形状は図 13(b)に示された 3d 電子帯での軌道の占有のアンバランスが原因となっており,軌道角運動量が消失していないことが原因とされた⁴⁶.

第3世代のSRストレージ・リングにおいては、軟X線領域のヘリカル・ウィグラ、アンジュレータのような非対称な挿入装置を有し偏光度が100%におよぶ高輝度円偏光が得られるようになったので、これを用いて非常にSN比の高いXMCDスペクトルが測定されるようになった⁴⁷. SchützのグループではXMCDを用いた磁気光学顕微鏡を開発した.X線領域でX線ビームを集光するためにフレネル帯板の一種のコンデンサ・ゾーン・プレートを用いた. これによってサブミクロンのサイズにまで集光することが可能となっている.光磁気ディスクの磁区パターンが25nmという高分解能が得られている⁴⁸.

5. おわりに

磁気光学効果のミクロな起源と、磁気光学効果を用いた人工格子・多層膜の物性評価, さらに、磁気光学効果研究の最近の展開、特に、近接場磁気光学効果・非線形磁気光学効果について、筆者の研究成果を中心に述べた.磁気光学効果の基礎についてのさらに詳しい記述については、拙著「光と磁気(改訂版)」を参照されたい.この小文が、これから物性研究に磁気光学効果を応用しようとしておられる研究者にとって、なんらかの手がかりになれば幸いである.

謝辞

ここに紹介した筆者の研究の一部は,科学研究費補助金基盤研究(A)(2)[課題番号 07555099] および基盤研究(B)(2)[課題番号 08455009]の助成を受けた.

参考文献

- 1 佐藤勝昭:光と磁気(改訂版) 朝倉書店,2001
- 2 佐藤勝昭:日本応用磁気学会第122回研究会「遷移金属・貴金属系磁気記録材料の磁気物性と磁区構造」 (2002.1.18 早稲田大学) テキスト
- 3 T. Katayama, H. Awano and N. Koshizuka: J. Phys. Soc. Jpn. 55 (1986) 2539.
- 4 K. Sato, H. Kida and T. Katayama: Jpn. J. Appl. Phys. 27 (1988) L237.
- 5 J. Zak, E.R. Moog and S.D. Bader: J. Magn. Magn. Mater. 89 (1990) 107
- 6 鈴木義茂, 片山利一: 応用物理学会誌63 (1994) 1261; 片山利一, 鈴木義茂: 日本応用磁気学会誌20 (1996) 764.
- 7 Y. Suzuki, T. Katayama, S. Yoshida, K. Tanaka and K. Sato: Phys. Rev. Lett. 68 (1992) 3355.
- 8 K. Takanashi, S. Mitani, M. Sano, H. Fujimori, H. Nakajima and A. Osawa, Appl. Phys. Lett. 67 (1995) 1016.
- 9 K. Sato, E. Takeda, M. Akita, M. Yamaguchi, K. Takanashi, S. Mitani, H. Fujimori, Y. Suzuki: J. Appl. Phys. 86 (1999) 4985.